

Change points 変化点一覧

Item 項目	Target part number 対象品番	Before change 変更前	After change 変更後	Purpose 目的
Material①/材料① Ceramic material セラミック素体	NCU15XH103*6*RC NCU18XH103*6*RB	Mn-Ni system Oxide semiconductor Mn-Ni系酸化物半導体	Mn-Ni system Oxide semiconductor additive will be changed. Mn-Ni系酸化物半導体添加材変更 *組成についてはノウハウのため開示を控えさせていただきます。 *We will not disclose the composition as it is a matter of know-how.	Performance improvement 製品実力改善のため
Material②/材料② Inner electrode/内部電極	NCU18XH103*6*RB	Ag system Ag厚膜	Ag system material ratio change Ag厚膜材配合率変更	Design optimization due to changes in ceramic material additives セラミック材料の添加材変更に伴う設計最適化による
Specification/仕様 B-constant(25/50℃) tolerance B定数(25/50℃)許容差	NCU15XH103D6*RC NCU18XH103D6*RB	±0.7%	±0.5%	Performance improvement 製品実力改善のため

We have no changes to quality, performance, and Murata Part Number.
その他、品質、性能、弊社品番に変更はありません。

Target P/N Specification 対象品番仕様

Blue : Change point
青字 : 変更点

muRata
INNOVATOR IN ELECTRONICS
PSE-24THM-0023

Size サイズ (mm/inch)	Target P/N 対象品番	Resistance 抵抗値 (25°C)	Resistance Tolerance 抵抗値許容差 (25°C)	B-constant B定数 (25/50°C)	B-constant Tolerance B定数許容差 (25/50°C)	
					Before change 変更前	After Change 変更後
1005/0402	NCU15XH103D6*RC	10kΩ	±0.5%	3380K	±0.7%	±0.5%
	NCU15XH103F6*RC		±1.0%		±1.0%	
	NCU15XH103E6*RC		±3.0%			
	NCU15XH103J6*RC		±5.0%			
1608/0603	NCU18XH103D6*RB	10kΩ	±0.5%	3380K	±0.7%	±0.5%
	NCU18XH103F6*RB		±1.0%		±1.0%	
	NCU18XH103E6*RB		±3.0%			
	NCU18XH103J6*RB		±5.0%			